

2SA641

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ(アルミナパシベーション形)／

PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR(Alumina Passivation)

低周波高利得増幅用／Audio Frequency High Gain Amplifier

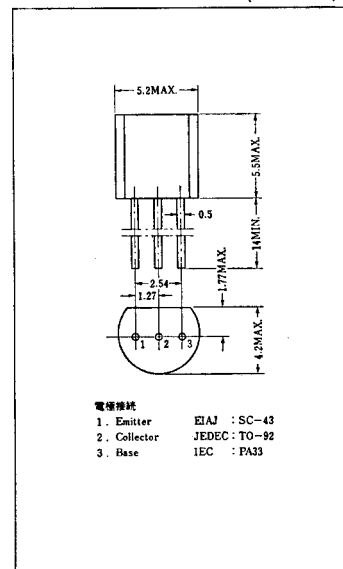
外形図／PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)

特 徴／FEATURES

- ・低周波における高利得増幅用として最適です。
- ・直流電流増幅率が大きい。 $h_{FE} : 300\text{TYP.}$ ($I_C = -0.5\text{mA}$)
- ・2SC923 とコンプリメンタリで使える。
- ・High h_{FE} $h_{FE} = 300\text{TYP.}$ at $I_C = -0.5\text{mA}$
- ・Complementary to NPN 2SC923.

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-45	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流	I_C	-30	mA
全損失	P_T	250	mW
ジャンクション温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -40\text{V}, I_E = 0$			-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3.0\text{V}, I_C = 0$			-100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -3.0\text{V}, I_C = -100\mu\text{A}$	80	280		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -3.0\text{V}, I_C = -0.5\text{mA}$	150	300	1000	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -3.0\text{V}, I_C = -0.5\text{mA}$		-0.63	-0.70	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -20\text{mA}, I_E = -2.0\text{mA}$		-0.20	-0.30	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -6.0\text{V}, I_E = 1.0\text{mA}$		100		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -6.0\text{V}, I_E = 0, f = 1.0\text{MHz}$		8.0		pF

 h_{FE} 区分/ h_{FE} Classification $h_{FE2}/H : 150 \sim 300$ F : 225 ~ 450 E : 350 ~ 700 U : 500 ~ 1000